

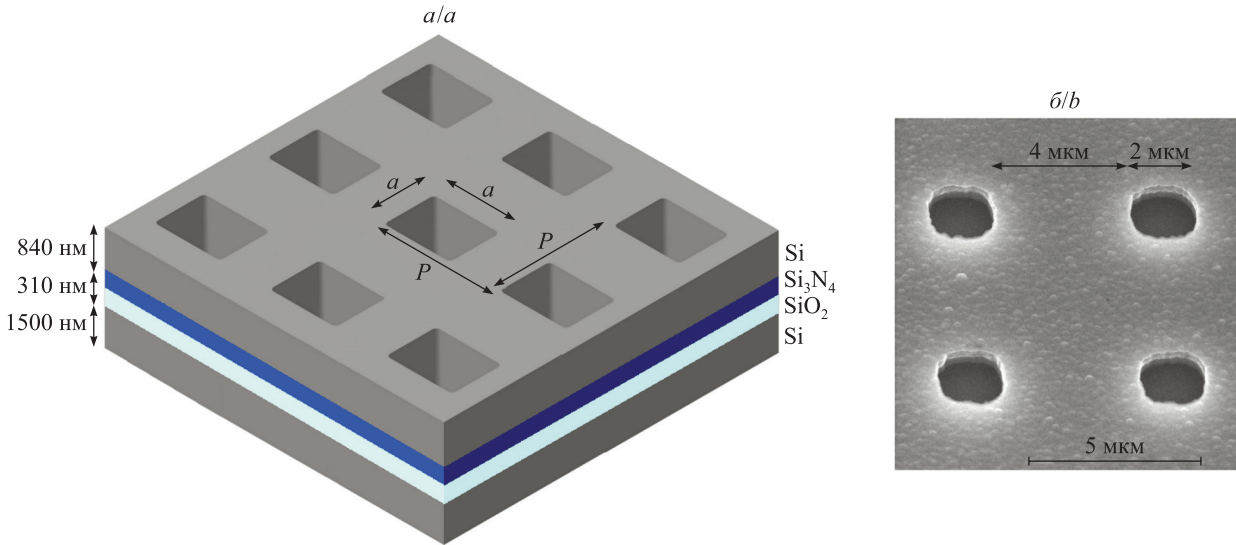


Рис. 1. Модель исследуемой структуры (а) и РЭМ-изображение поверхности структуры Si/Si₃N₄/SiO₂/Si с размером окошек 2 мкм и периодом их расположения 6 мкм (б)

Fig. 1. Model of the simulated structure (a) and scanning electron microscopy image of the surface of the Si/Si₃N₄/SiO₂/Si structure with a window size of 2 μm and a window period of 6 μm (b)